

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

ТОМ 27 1/24

Индекс по каталогам «Пресса России» и «Урал Пресс» 47215



МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Учредитель:

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский
технологический университет «МИСИС»
(НИТУ МИСИС)

Известия высших учебных заведений.
Материалы электронной техники.
2024. Т. 27, № 4(105).

Журнал основан в 1998 г.
Издается один раз в 3 месяца.

Издатель: Национальный исследовательский
технологический университет «МИСИС»,
119049, г. Москва, Ленинский просп., д. 4, стр. 1.

Почтовый адрес редакции:
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 4, стр. 1,
ЦНПИ, НИТУ МИСИС (ячейка 398).

Тел.: (495) 638–45–31, e-mail: met.misis@inbox.ru

*Отпечатано в типографии
Издательского дома «МИСИС»,
119049, г. Москва, Ленинский просп., д. 4, стр. 1.
тел.: (499) 236–76–17.*

Подписано в печать 17.04.2024.

Формат 60×90/8. Печать офсетная.

Заказ № 21842. Бумага офсетная.

Печ. л. 12,75. Тираж 150. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (ПИ № ФС 77–59522 от 23.10.2014),
предыдущее свидетельство № 016108 от 15.05.1997
(Минпечати РФ).

Редактор М. И. Воронова
Корректор Н. Э. Хотинская
Верстка А. А. Космынина

Главный редактор

ПАРХОМЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
д-р физ.-мат. наук, проф. (НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Заместители главного редактора

КИСЕЛЕВ Дмитрий Александрович, канд. физ.-мат. наук,
КОСТИШИН Владимир Григорьевич, д-р физ.-мат. наук, проф.
(НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Ответственный секретарь редакции

Космынина Арина Александровна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Акчурин Р. Х., д-р техн. наук, проф. (МИТХТ, Москва, Россия)

Асеев А. Л., акад. РАН (ИФП СО РАН, Новосибирск, Россия)

Барбера А., д-р биологии (Институт ядерных исследований, Мехико, Мексика)

Бдикин И. К., д-р физ.-мат. наук (Университет Авейро, Авейро, Португалия)

Бублик В. Т., д-р физ.-мат. наук, проф. (НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Васкес Л., проф., д-р физики (Университет Комплутенс, Мадрид, Испания)

Вуль А. Я., д-р физ.-мат. наук, проф. (ФТИ им. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия)

Гуляев Ю. В., акад. РАН (ИРЭ РАН, Москва, Россия)

Двуреченский А. В., проф., член-корр. РАН (ИФП СО РАН, Новосибирск, Россия)

Калошкин С. Д., д-р физ.-мат. наук, проф. (НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Кобелева С. П., канд. физ.-мат. наук, доц. (НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Кожитов Л. В., д-р техн. наук, проф. (НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Козлова Н. С., канд. физ.-мат. наук (НИТУ МИСИС, Москва, Россия)

Литовченко В. Г., акад. УКАН (ИФП им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина)

Ломонова Е. Е., д-р техн. наук (ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия)

Мансуров З. А., д-р хим. наук, проф. (Институт проблем горения, Алматы, Казахстан)

Маппс Д. Дж., проф. (Университет Плимута, Плимут, Великобритания)

Пенг Х. X., проф. (Чжэцзянский университет, Ханчжоу, Китай)

Петров А. В., канд. физ.-мат. наук (НПЦ НАНБ по материаловедению, Минск, Беларусь)

Сафаралиев Г. К., проф., член-корр. РАН (ДГУ, Махачкала, Россия)

Соболев Н. А., проф. (Университет Авейро, Авейро, Португалия)

Солнышкин А. В., д-р физ.-мат. наук, проф. (ТГУ, Тверь, Россия)

Табачкова Н. Ю., канд. физ.-мат. наук (ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия)

Тодуа П. А., д-р физ.-мат. наук, проф. (ОАО «НИЦПВ», Москва, Россия)

Федотов А. К., проф. (БГУ, Минск, Беларусь)

Хернандо Б., проф. (Университет Овьедо, Овьедо, Испания)

Чаплыгин Ю. А., проф., член-корр. РАН (МИЭТ, Москва, Россия)

Шварцбург А. Б., д-р физ.-мат. наук (ОИВТ РАН, Москва, Россия)

Щербачев К. Д., канд. физ.-мат. наук (XRD Eigenmann GmbH, Шнайттах, Германия)

Журнал по решению Высшей аттестационной комиссии

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Materialy elektronnoi tekhniki

Materials of Electronics Engineering

Vol. 27

1/24



MISIS
UNIVERSITY
OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

Founders:

National University of Science
and Technology «MISIS»

**Izvestiya vuzov. Materialy
elektronnoi tekhniki =
Materials of Electronics
Engineering. 2024, vol. 27, no. 1**

The journal was founded in 1998
and is published once in 3 months.

Address of correspondence:

National University of Science
and Technology «MISIS»,
4–1 Leninskiy Ave., Moscow 119991, Russia
Tel./fax: +7(495)638–45–31,
e-mail: met.misis@inbox.ru
http://met.misis.ru

The journal
«Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii.
Materialy Elektronnoi Tekhniki =
Materials of Electronics Engineering»
is registered in Federal Service for Supervision
in the Sphere of Mass Communications
(PI number FS 77–59522 of 10.23.2014),
the previous certificate number 016108
from 15.05.1997.

Editor M. I. Voronova
Corrector N. E. Khotynskaya

Editor-in-Chief
Yuri N. Parkhomenko, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof.,
National University of Science and Technology "MISIS", Moscow, Russia

Deputy Editor-in-Chief
Dmitry A. Kiselev, PhD, Cand. Sci. (Phys.–Math.),
Department of the Material Science of Semiconductors and Dielectrics at the MISIS

Vladimir G. Kostishin, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof.,
Head of Department of the Technology of Electronic Materials at the MISIS

Assistant Editor
Arina A. Kosmynina

EDITORIAL BOARD

R. Kh. Akchurin, Dr. Sci. (Eng.), Prof.,
Lomonosov Moscow State University
of Fine Chemical Technologies, Moscow, Russia

A. L. Aseev, Academician of the Russian Academy of
Sciences (RAS), Institute of Semiconductor Physics,
SB RAS, Novosibirsk, Russia

I. K. Bdin, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Aveiro Institute of
Nanotechnology (AIN), University of Aveiro, Aveiro,
Portugal

V. T. Bublik, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof.,
National University of Science and Technology
"MISIS", Moscow, Russia

Yu. A. Chaplygin, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences (RAS), Prof., National Research
University of Electronic Technology, Moscow, Russia

A. V. Dvurechenskii, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences (RAS), Prof.,
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia

A. K. Fedotov, Prof., Belarusian State University,
Department of Energy Physics, Minsk, Belarus

Yu. V. Gulyaev, Academician of the Russian Academy
of Sciences (RAS), Kotelnikov Institute of Radio
Engineering and Electronics of RAS, Moscow, Russia

A. Heredia-Barbero, PhD, Dr. (Biol.), Instituto de
Ciencias Nucleares de la UNAM, Mexico City, Mexico

B. Hernando, Prof., Universidad de Oviedo, Oviedo, Spain

S. D. Kaloshkin, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof., National
University of Science and Technology "MISIS",
Moscow, Russia

S. P. Kobeleva, Cand. Sci. (Phys.–Math.), Assoc. Prof.,
National University of Science and Technology
"MISIS", Moscow, Russia

L. V. Kozhitov, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof., National
University of Science and Technology "MISIS",
Moscow, Russia

N. S. Kozlova, Cand. Sci. (Phys.–Math.), National
University of Science and Technology "MISIS",
Moscow, Russia

V. G. Litovchenko, Academician of the Ukrainian
Academy of Sciences, Institute of Semiconductors
Physics, National Academy of Sciences in Ukraine,
Kiev, Ukraine

E. Lomonova, Dr. Sci. (Eng.), A.M. Prokhorov General
Physics Institute, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Z. A. Mansurov, Dr. Sci. (Chim.), Prof., Al Farabi Kazakh
National University, Institute of Combustion Problems,
Almaty, Kazakhstan

D. J. Mapps, Prof., University of Plymouth, Plymouth,
United Kingdom

H.-X. Peng, Prof., Zhejiang University, Hangzhou, China

A. V. Petrov, Cand. Sci. (Phys.–Math.), Scientific Practical
Materials Research Centre of NAS of Belarus, Minsk,
Belarus

G. K. Safarliev, Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences (RAS), Prof.,
Dagestan State University, Makhachkala,
Russia

K. D. Shcherbachov, Cand. Sci. (Phys.–Math.),
XRD Eigenmann GmbH, Schnaittach, Germany

A. B. Shvartsburg, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Joint Institute
for High Temperatures Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

N. A. Sobolev, Prof., Aveiro University, Aveiro, Portugal

A. V. Solnyshkin, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof., Tver State
University, Tver, Russia

N. Yu. Tabachkova, Cand. Sci. (Phys.–Math.),
A.M. Prokhorov General Physics Institute, Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russia

P. A. Todua, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof., Research
Center for Surface and Vacuum, Moscow, Russia

L. Vazquez, Ph. D., Prof., Universidad Complutense
de Madrid, Madrid, Spain

A. Ya. Vul, Dr. Sci. (Phys.–Math.), Prof., Ioffe Physico–
Technical Institute, Saint Petersburg, Russia

In accordance with a resolution of the Higher Attestation Committee at the Ministry of Education of the Russian Federation,
the Journal is included in the «List of Periodical and Scientific and Technical Publications Issued in the Russian Federation
in which the Publication of the Main Results of Dr.Sci. Theses is Recommended».

СОДЕРЖАНИЕ

**Д. Г. Муратов, Л. В. Кожитов, И. В. Запороцкова, А. В. Попкова,
В. В. Слепцов, А. В. Зорин**

Металлорганические каркасные структуры и композиты на их основе: особенности строения,
методы синтеза, электрохимические свойства и перспективы (обзор) 5

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЭЛЕКТРИКИ

**А. М. Кислюк, И. В. Кубасов, А. В. Турутин, А. А. Темиров, А. С. Шпортенко,
В. В. Куц, М. Д. Малинкович**

Электрофизические свойства, мемристивное и резистивное переключение
в заряженных доменных стенках в ниобате лития 35

НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

**А. А. Темиров, И. В. Кубасов, А. В. Турутин, Т. С. Ильина, А. М. Кислюк,
Д. А. Киселев, Е. А. Скрылева, Н. А. Соболев, И. В. Салимон, Н. В. Батрамеев,
М. Д. Малинкович, Ю. Н. Пархоменко**

Получение кремний–углеродных пленок методом плазмохимического осаждения
с индукционным ассистированием 56

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. В. Телегин, Ж. Ж. Намсараев, В. Д. Бессонов, В. С. Теплов, А. В. Огнев

Синтез тонкопленочных магнитных структур для спин–орбитроники 66

**М. Г. Лаврентьев, М. В. Воронов, А. А. Иванов, В. П. Панченко,
Н. Ю. Табачкова, М. К. Таперо, И. Ю. Ярков**

Механические свойства среднетемпературных термоэлектрических материалов
на основе теллуридов олова и свинца 75

**Н. Ю. Комаровский, Ю. Н. Пархоменко, Е. В. Молодцова,
Е. О. Журавлев, В. А. Чупраков, Р. Ю. Козлов, С. Н. Князев, А. Г. Белов**

Физические и технологические причины возникновения канальной неоднородности
в монокристаллах InSb, сильнолегированных Te 85

М. С. Афанасьев, Е. И. Гольдман, А. И. Стогний, Г. В. Чучева

Тонкие пленки $Y_3Fe_5O_{12}/Ba_{0,8}Sr_{0,2}TiO_3$: синтез и перспективы интеграции 96

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Юрия Николаевича Пархоменко с юбилеем! 2-я стр. обложки

CONTENTS

**D. G. Muratov, L. V. Kozhitov, I. V. Zaporotskova, A. V. Popkova,
V. V. Sleptsov, A. V. Zorin**

Metal–organic frame structures and composites based on them: structural features, synthesis methods, electrochemical properties and prospects (review) 5—34

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. DIELECTRICS

**A. M. Kislyuk, I. V. Kubasov, A. A. Temirov, A. V. Turutin,
A. S. Shportenko, V. V. Kuts, M. D. Malinkovich**

Electrophysical properties, memristive and resistive switching in charged domain walls in lithium niobate 35—55

NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY

**A. A. Temirov, I. V. Kubasov, A. V. Turutin, T. S. Ilina,
A. M. Kislyuk, D. A. Kiselev, E. A. Skryleva, N. A. Sobolev, I. A. Salimon,
N. V. Batrameev, M. D. Malinkovich, Yu. N. Parkhomenko**

Creattion of silicon–carbon films by induction assisted plasma chemical deposition 56—65

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND THEIR STUDY

A. V. Telegin, Zh. Zh. Namsaraev, V. D. Bessonov, V. S. Teplov, A. V. Ognev

Synthesis of thin–film magnetic structures for spin–orbitronics 66—74

**M. G. Lavrentev, M. V. Voronov, A. A. Ivanov, V. P. Panchenko,
N. Yu. Tabachkova, M. K. Tapero, I. Yu. Yarkov**

Mechanical properties of medium–temperature thermoelectric materials based on tin and lead tellurides 75—84

**N. Yu. Komarovskiy, Yu. N. Parkhomenko, E. V. Molodtsova, E. O. Zhuravlev,
V. A. Chuprakov, R. Yu. Kozlov, S. N. Knyazev, A. G. Belov**

Physical and technological causes of channel inhomogeneity in InSb single crystals heavily doped with Te 85—95

M. S. Afanasiev, E. I. Goldman, A. I. Stogniy, G. V. Chucheva

Thin films $Y_3Fe_5O_{12}/Ba_{0.8}Sr_{0.2}TiO_3$: synthesis and integration prospects 96—102

Congratulations on the anniversary Yuri N. Parkhomenko 2nd cover